



## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **2001085373 A**(43) Date of publication of application: **30.03.01**

(51) Int. Cl.

**H01L 21/304****B24B 37/00****C09K 3/14**(21) Application number: **11263859**(22) Date of filing: **17.09.99**(71) Applicant: **HITACHI CHEM CO LTD**(72) Inventor:  
**HIRAI KEIZO**  
**HAGA KOJI**  
**SAKURADA TAKASHI****(54) CMP POLISHING LIQUID****(57) Abstract:**

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a flat surface, without a flaw, with a large polishing speed ratio between a silicon oxide film and a silicon nitride film by, related to a CMP polishing liquid, diffusing the abrasive grain with organic compound sticking to it by a specified range of wt.% in water.

**SOLUTION:** The abrasive grain such as silicon oxide, silicon nitride, aluminum, zirconia, cerium oxide, boron

nitride, diamond, and hard carbon, etc., to which an organic compound using an anionic surfactant, by 5-30 wt.%, such as alphaolefinsulfonate, alkyl benzene sulfonate, alkyl benzene sulfonate salt, alkyl sulfate, methyl taurine acid salt is sticking, is diffused in water to constitute a CMP(chemical-mechanical) polishing liquid. Thus, a surface, which is to be polished, is flattened without a flaw, with a large polishing speed ratio between a silicon oxide film and a silicon nitride film.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2001-85373  
(P2001-85373A)

(43) 公開日 平成13年3月30日 (2001.3.30)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テマコード* (参考)
H 0 1 L 21/304	6 2 2	H 0 1 L 21/304	6 2 2 D 3 C 0 5 8
B 2 4 B 37/00		B 2 4 B 37/00	H
C 0 9 K 3/14	5 5 0	C 0 9 K 3/14	5 5 0 D

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平11-263859

(22) 出願日 平成11年9月17日 (1999.9.17)

(71) 出願人 000004455

日立化成工業株式会社  
東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

(72) 発明者 平井 圭三

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化  
成工業株式会社山崎事業所内

(72) 発明者 芳賀 浩二

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化  
成工業株式会社山崎事業所内

(74) 代理人 100071559

弁理士 若林 邦彦

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 CMP研磨液

(57) 【要約】

【課題】 被研磨面を、傷なく、酸化珪素膜と窒化珪素膜の研磨速度比を大きく、凸部を選択的に研磨でき、高平坦化することが可能であるCMP研磨液を提供する。

【解決手段】 砥粒に対して5～30重量%の有機化合物が付着している砥粒を水中に分散してなるCMP研磨液。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 砥粒に対して5～30重量%の有機化合物が付着している砥粒を水中に分散してなるCMP研磨液。

【請求項2】 砥粒に付着している有機化合物と水中に溶解又は分散している有機化合物の合計量が砥粒に対して50～500重量%である請求項1記載のCMP研磨液。

【請求項3】 有機化合物が砥粒の表面電荷と反対の電荷を有するイオン系界面活性剤である請求項1又は2記載のCMP研磨液。

【請求項4】 表面電荷がプラスである砥粒にアニオン系界面活性剤が付着している請求項1、2又は3記載のCMP研磨液。

【請求項5】 アニオン系界面活性剤が有機酸とアンモニア又はアミンとを等モル混合して得た塩であり、塩を形成していないフリーのアンモニア又はアミンの割合が10モル%以下である請求項4記載のCMP研磨液。

【請求項6】 0.5～10重量%の酸化セリウム粒子を砥粒として含有する請求項1、2、3、4又は5記載のCMP研磨液。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体素子製造工程のうち、層間絶縁膜の平坦化工程又はシャロー・トレンチ分離の形成工程等において使用されるCMP (Chemical Mechanical Polishing) 研磨液及び研磨方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】超大規模集積回路の分野において実装密度を高めるために種々の微細加工技術が研究、開発されており、既に、デザインルールは、サブハーフミクロンのオーダーになっている。このような厳しい微細化要求を満足するための技術の一つにCMP技術がある。この技術は、半導体装置の製造工程において、露光を施す層を完全に平坦化し、露光技術の負担を軽減し、歩留まりを安定させることができるため、例えば、層間絶縁膜の平坦化やシャロー・トレンチ分離等を行う際に必須となる技術である。

【0003】従来、半導体装置の製造工程において、プラズマ-CVD (Chemical Vapor Deposition、化学的蒸着法)、低圧-CVD等の方法で形成される酸化珪素絶縁膜等を平坦化するためのCMP研磨液として、コロイダルシリカを研磨粒子とする高PH (ペーハー) の研磨液が多用されてきた。しかしながら、この研磨液には、酸化珪素膜の研磨速度が十分ではない、ウエハ全面が均一に削れない (すなわち高平坦化できない)、あるいはスクラッチと呼ばれる研磨傷が多い等の問題がある。

【0004】CMP研磨液は、上記した絶縁膜の平坦化

以外に、シャロー・トレンチ分離の形成工程においても使用されている。デザインルール0.5 $\mu$ m以上の世代では、集積回路内の素子分離にLOCOS (シリコン局所酸化) 法が用いられてきたが、素子分離幅をより狭くするため、シャロー・トレンチ分離法が用いられている。シャロー・トレンチ分離法では、基板上に成膜した余分の酸化珪素膜を除くためにCMPが使用され、研磨を停止させるために、酸化珪素膜の下に窒化珪素膜がストッパとして形成されるのが一般的である。したがって、酸化珪素膜研磨速度は窒化珪素膜研磨速度よりできるだけ大きいことが望ましい。しかし、従来のコロイダルシリカを用いた研磨液は、酸化珪素膜と窒化珪素膜の研磨速度比が高々3程度と小さく、シャロー・トレンチ分離用としては実用的ではない。

【0005】一方、フォトマスクやレンズ等のガラス表面研磨剤としては、酸化セリウムを用いた研磨液が多用されている。酸化セリウム研磨液は研磨傷が発生し難く、また、研磨速度が早いという特長を有する。そのため、酸化セリウム研磨液を半導体用研磨液として適用する検討が近年行われているが、未だコロイダルシリカを用いた研磨剤にとって変わるには至っていない。その理由は、コロイダルシリカを用いた研磨剤の問題点のうち研磨速度と研磨傷については、十分に吟味した酸化セリウム粒子を用いることで良い結果が得られつつあるが、高平坦化及び酸化珪素と窒化珪素の研磨速度比の点で十分な特性を示す酸化セリウム研磨液がなかったためである。

【0006】特開平8-302338号公報には、研磨粒子を含有した研磨粒子水溶液に増粘剤を添加した高粘性スラリーを用いる方法が提案されており、粒子の凝集沈殿がないため傷が少なく、より少ないスラリー使用量で研磨できるとされているが、凸部を選択的に研磨して高平坦化できる等の効果はない。

## 【0007】

【発明が解決しようとする課題】請求項1～6記載の発明は、被研磨面を、傷なく、酸化珪素膜と窒化珪素膜の研磨速度比を大きく、凸部を選択的に研磨でき、高平坦化することが可能であるCMP研磨液を提供するものである。

## 【0008】

【課題を解決するための手段】本発明は、砥粒に対して5～30重量%の有機化合物が付着している砥粒を水中に分散してなるCMP研磨液に関する。また、本発明は、砥粒に付着している有機化合物と水中に溶解又は分散している有機化合物の合計量が砥粒に対して50～500重量%である前記のCMP研磨液に関する。また、本発明は、有機化合物が砥粒の表面電荷と反対の電荷を有するイオン系界面活性剤である前記のCMP研磨液に関する。

【0009】また、本発明は、表面電荷がプラスである

(

## ( )

(

( )

( )

( )

【0016】本発明で、砥粒に対して5〜30重量%の量の有機化合物を砥粒に安定して付着させる点、研磨特性の点等から、有機化合物が砥粒の表面電荷と反対の電荷を有するイオン系界面活性剤であることが好ましい。例えば、砥粒として酸化セリウム粒子を用いた場合、有機化合物を含んでいない純水中では酸化セリウム粒子のゼータ電位はプラスとなる傾向が強く、したがってアニオン系界面活性剤を用いることが好ましい。また、やはり酸化セリウム粒子を用いた場合でも、アルカリ性の有機化合物又はアンモニア等のpH調整剤でpHをアルカリ性にすれば、ゼータ電位はプラスとなる傾向が強いので、この場合はカチオン系界面活性剤を用いることが好ましい。

【0016】本発明で、砥粒に対して5〜30重量%の量の有機化合物を砥粒に安定して付着させる点、研磨特性の点等から、有機化合物が砥粒の表面電荷と反対の電荷を有するイオン系界面活性剤であることが好ましい。例えば、砥粒として酸化セリウム粒子を用いた場合、有機化合物を含んでいない純水中では酸化セリウム粒子のゼータ電位はプラスとなる傾向が強く、したがってアニオン系界面活性剤を用いることが好ましい。また、やはり酸化セリウム粒子を用いた場合でも、アルカリ性の有機化合物又はアンモニア等のpH調整剤でpHをアルカリ性にすれば、ゼータ電位はプラスとなる傾向が強いので、この場合はカチオン系界面活性剤を用いることが好ましい。

【0016】本発明で、砥粒に対して5〜30重量%の量の有機化合物を砥粒に安定して付着させる点、研磨特性の点等から、有機化合物が砥粒の表面電荷と反対の電荷を有するイオン系界面活性剤であることが好ましい。例えば、砥粒として酸化セリウム粒子を用いた場合、有機化合物を含んでいない純水中では酸化セリウム粒子のゼータ電位はプラスとなる傾向が強く、したがってアニオン系界面活性剤を用いることが好ましい。また、やはり酸化セリウム粒子を用いた場合でも、アルカリ性の有機化合物又はアンモニア等のpH調整剤でpHをアルカリ性にすれば、ゼータ電位はプラスとなる傾向が強いので、この場合はカチオン系界面活性剤を用いることが好ましい。

【0016】本発明で、砥粒に対して5〜30重量%の量の有機化合物を砥粒に安定して付着させる点、研磨特性の点等から、有機化合物が砥粒の表面電荷と反対の電荷を有するイオン系界面活性剤であることが好ましい。例えば、砥粒として酸化セリウム粒子を用いた場合、有機化合物を含んでいない純水中では酸化セリウム粒子のゼータ電位はプラスとなる傾向が強く、したがってアニオン系界面活性剤を用いることが好ましい。また、やはり酸化セリウム粒子を用いた場合でも、アルカリ性の有機化合物又はアンモニア等のpH調整剤でpHをアルカリ性にすれば、ゼータ電位はプラスとなる傾向が強いので、この場合はカチオン系界面活性剤を用いることが好ましい。

【0016】本発明で、砥粒に対して5〜30重量%の量の有機化合物を砥粒に安定して付着させる点、研磨特性の点等から、有機化合物が砥粒の表面電荷と反対の電荷を有するイオン系界面活性剤であることが好ましい。例えば、砥粒として酸化セリウム粒子を用いた場合、有機化合物を含んでいない純水中では酸化セリウム粒子のゼータ電位はプラスとなる傾向が強く、したがってアニオン系界面活性剤を用いることが好ましい。また、やはり酸化セリウム粒子を用いた場合でも、アルカリ性の有機化合物又はアンモニア等のpH調整剤でpHをアルカリ性にすれば、ゼータ電位はプラスとなる傾向が強いので、この場合はカチオン系界面活性剤を用いることが好ましい。

【0016】本発明で、砥粒に対して5〜30重量%の量の有機化合物を砥粒に安定して付着させる点、研磨特性の点等から、有機化合物が砥粒の表面電荷と反対の電荷を有するイオン系界面活性剤であることが好ましい。例えば、砥粒として酸化セリウム粒子を用いた場合、有機化合物を含んでいない純水中では酸化セリウム粒子のゼータ電位はプラスとなる傾向が強く、したがってアニオン系界面活性剤を用いることが好ましい。また、やはり酸化セリウム粒子を用いた場合でも、アルカリ性の有機化合物又はアンモニア等のpH調整剤でpHをアルカリ性にすれば、ゼータ電位はプラスとなる傾向が強いので、この場合はカチオン系界面活性剤を用いることが好ましい。

板に形成された酸化珪素膜だけでなく、所定の配線を有する配線板に形成された酸化珪素膜、ガラス、窒化珪素等の無機絶縁膜、フォトマスク・レンズ・プリズムなどの光学ガラス、ITO等の無機導電膜、ガラス及び結晶質材料で構成される光集積回路・光スイッチング素子・光導波路、光ファイバーの端面、シンチレータ等の光学用単結晶、固体レーザー単結晶、青色レーザーLED用サファイヤ基板、SiC、GaP、GaAs等の半導体単結晶、磁気ディスク用ガラス基板、磁気ヘッド等を研磨することができる。

#### 【0019】

【実施例】次に、実施例により本発明を説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

#### 【0020】実施例1

〔酸化セリウム粒子の製造とその水溶液のpH及びゼータ電位〕炭酸セリウム水和物2kgを白金製容器に入れ、750℃で2時間空気中で焼成し粉碎して酸化セリウム粒子を得た。この酸化セリウム粒子が水に対して0.01重量%になるように脱イオン水を加えた液でpH及びゼータ電位を測定したところ、それぞれ6.1及び+15mVであった。

【0021】〔CMP研磨液の調整〕上記酸化セリウム粒子、アクリル酸とアクリル酸メチルを1:1（モル比）で共重合し、アンモニアで中和した重量平均分子量4,000のアニオン系ポリマー（フリーアンモニアの割合は3%）及び純水を、酸化セリウムが2重量%、前記アニオン系ポリマーが酸化セリウムに対して1重量%となるように混合し、横型湿式超微粒分散粉碎機を用いて1400min<sup>-1</sup>で120分間粉碎処理をしてスラリーを得た（これをスラリーAとする）。得られたスラリーA中の酸化セリウム粒子に付着している前記アニオン系ポリマー量及び水中に溶解している前記アニオン系ポリマー量を定量した結果、酸化セリウムに対して0.45重量%のポリマーが酸化セリウム粒子に付着し、酸化セリウムに対して0.55重量%のポリマーが水中に溶解していた。また、スラリーAを酸化セリウム粒子が水に対して0.01重量%になるように希釈してpH及びゼータ電位を測定した結果、それぞれ6.5及び-5mVであった。

【0022】次に、スラリーAに、上記ポリマーが酸化セリウムに対して200重量%となる量の前記アニオン系ポリマーを追加混合してスラリーを得た（これをスラリーBとする）。得られたスラリーB中の酸化セリウム粒子に付着している前記アニオン系ポリマー量及び水中に溶解している前記アニオン系ポリマー量を定量した結果、酸化セリウムに対して6重量%のポリマーが酸化セリウム粒子に付着し、酸化セリウムに対して194重量%のポリマーが水中に溶解していた。また、スラリーBを酸化セリウム粒子が水に対して0.01重量%になるように希釈してpH及びゼータ電位を測定した結果、それ

ぞれ7.1及び-25mVであった。

【0023】スラリーBをCMP研磨液として用い、実際に8インチウエハ上の酸化珪素膜及び窒化珪素膜を荏原（株）製CMP研磨装置で研磨した結果（研磨荷重30kPa、定盤回転数50min<sup>-1</sup>、研磨液供給量毎分200ml）酸化珪素膜の窒化珪素膜に対する研磨速度比は100であった。また、0.5μmの段差がパターン形成された酸化珪素膜を研磨した結果、段差は300Åとなり、顕微鏡観察した結果、研磨傷も認められなかった。

#### 【0024】実施例2

上記スラリーAに、重量平均分子量7000のポリアクリル酸アンモニウム塩（フリーアンモニアの割合は4.5%）を、酸化セリウム粒子に対して400重量%となるように混合してスラリーを得た（これをスラリーCとする）。スラリーCの酸化セリウムに付着しているポリマー量及び水中に溶解しているポリマー量を定量した結果、酸化セリウム粒子に対して25重量%のポリマーが酸化セリウムに付着し、酸化セリウム粒子に対して375重量%のポリマーが水中に溶解していた。また、スラリーCを酸化セリウム粒子が水に対して0.01重量%になるように希釈してpH及びゼータ電位を測定した結果、それぞれ7.15及び-35mVであった。

【0025】スラリーCをCMP研磨液として用い、実施例1と同様に研磨した結果、研磨速度比は50であった。また、0.5μmの段差がパターン形成された酸化珪素膜を研磨した結果、段差は150Åとなり、研磨傷も認められなかった。

#### 【0026】比較例1

実施例1で得られたスラリーAをCMP研磨液として用い、実施例1と同様に研磨した結果、酸化珪素膜/窒化珪素膜の研磨速度比はわずかに5であった。また、0.5μmの段差がパターン形成された酸化珪素膜を研磨した結果、段差は3000Å以上残り、凹部がさらに削れるいわゆるディッシングが起きた。

#### 【0027】比較例2

実施例1で得られたスラリーAに、重量平均分子量3000のポリアクリル酸アンモニウム塩（フリーアンモニアの割合4.5%）を、酸化セリウム粒子に対して650重量%となるように混合しスラリーを得た（これをスラリーDとする）。スラリーDの酸化セリウムに付着しているポリマー量及び水中に溶解しているポリマー量を定量した結果、酸化セリウム粒子に対して35重量%のポリマーが酸化セリウムに付着し、酸化セリウム粒子に対して615重量%のポリマーが水中に溶解していた。また、スラリーDを酸化セリウム粒子が水に対して0.01重量%になるように希釈してpH及びゼータ電位を測定した結果、それぞれ7.2及び-45mVであった。

【0028】スラリーDをCMP研磨液として用い、実施例1と同様に研磨した結果、研磨速度比は25であった。また、0.5μmの段差がパターン形成された酸化

(5) 開2001-85373 (P2001-853PJL

珪素膜を研磨した結果、段差は1100Åとなり、研磨傷も50個認められた。

【0029】

【発明の効果】請求項1～6記載のCMP研磨液は、被

研磨面を、傷なく、酸化珪素膜と窒化珪素膜の研磨速度比を大きく、凸部を選択的に研磨でき、高平坦化することが可能なものである。

---

フロントページの続き

(72)発明者 櫻田 剛史  
茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化  
成工業株式会社山崎事業所内

Fターム(参考) 3C058 AA07 CB01 CB02 CB03 CB10  
DA02 DA17